

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
【発行日】平成 24 年 1 月 19 日 (2012.1.19)

【公開番号】特開 2010-129981 (P2010-129981A)  
【公開日】平成 22 年 6 月 10 日 (2010.6.10)  
【年通号数】公開・登録公報 2010-023  
【出願番号】特願 2008-306678 (P2008-306678)  
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/205 (2006.01)

C 2 3 C 16/44 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/205

C 2 3 C 16/44 J

【手続補正書】  
【提出日】平成 23 年 11 月 25 日 (2011.11.25)

【手続補正 1】  
【補正対象書類名】特許請求の範囲  
【補正対象項目名】全文  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【特許請求の範囲】

【請求項 1】

反応炉内に処理対象の基板を収容し、前記基板にエピタキシャル層を気相成長させてエピタキシャルウェーハを製造するエピタキシャルウェーハ製造方法であって、

前記基板に前記エピタキシャル層を形成するためのソースガスを供給して気相成長させる気相成長工程において、所定の時点まで前記ソースガスだけを供給し、前記所定の時点から前記ソースガスと塩化水素を共に供給するエピタキシャルウェーハ製造方法。

【請求項 2】

前記塩化水素の供給量は、前記気相成長によるエピタキシャル層の成長を維持可能な範囲である

請求項 1 に記載のエピタキシャルウェーハ製造方法。

【請求項 3】

前記反応炉は、前記基板を収容する、少なくとも一部が石英で構成された収容部を有し、前記石英の部分を介して前記収容部内を加熱し、又は前記石英の部分を介して前記収容部内の温度を測定することにより、前記収容部内の温度の制御を行う

請求項 1 又は請求項 2 に記載のエピタキシャルウェーハ製造方法。

【請求項 4】

前記気相成長工程の終了近傍において、前記塩化水素の供給量を変化させる  
請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか一項に記載のエピタキシャルウェーハ製造方法。